

## Осцилляционный акустоэлектронный эффект в квазидвумерных проводниках в квантующем магнитном поле

О. В. Кириченко, В. Г. Песчанский

Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины,  
пр. Ленина, 47, г. Харьков, 61103 Украина  
E-mail: kirichenko@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 24 мая 2001 г.

Показано, что квазидвумерный характер электронного энергетического спектра слоистого проводника приводит к существенному уменьшению поглощения продольного звука, распространяющегося вдоль нормали к слоям в квантующем магнитном поле.

Показано, що квазідвовимірний характер електронного енергетичного спектру шаруватого провідника приводить до суттєвого зменшення поглинання поздовжнього звуку, що розповсюджується вздовж нормалі до шарів у квантуючому магнітному полі.

PACS: 72.55.+s

Акустоэлектронные явления в вырожденных проводниках в присутствии достаточно сильного магнитного поля весьма чувствительны к виду электронного энергетического спектра [1,2]. Они были успешно использованы для восстановления по экспериментальным данным поверхности Ферми — основной характеристики спектра электронов проводимости в металлах. При низких температурах, когда температурное размытие фермиевской функции распределения носителей заряда много меньше расстояния между квантованными магнитным полем уровнями энергии, зависимость декремента затухания звука от величины магнитного поля  $H$  имеет вид гигантских осцилляций [3].

При столь низких температурах затухание звуковых волн в вырожденных проводниках в основном вызвано взаимодействием носителей заряда с волной. С достаточной степенью точности поглощение звуковой энергии в единицу времени в единице объема проводника равно диссипативной функции электронов

$$Q = T\dot{S}, \quad (1)$$

где  $T$  — температура;  $S$  — плотность энтропии электронов. Величина  $S$  определяется следующим соотношением [4,5]:

$$S = - \text{Sp} \{ \hat{f} \ln \hat{f} + (1 - \hat{f}) \ln (1 - \hat{f}) \}, \quad (2)$$

в котором неравновесный статистический оператор  $\hat{f}$  удовлетворяет кинетическому уравнению

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial t} + \hat{\mathbf{v}} \frac{\partial \hat{f}}{\partial \mathbf{r}} + [\hat{H}_0 + \hat{H}_1, \hat{f}] = \hat{W}_{\text{coll}} \{ \hat{f} \}. \quad (3)$$

Звуковая волна возбуждает сопутствующую ей электромагнитную волну и приводит к перенормировке энергии электронов  $\epsilon$  на величину  $\delta\epsilon = \Lambda_{ij} u_{ij}$ . Это возмущение электронной системы колебаниями решетки учитывает поправка  $\hat{H}_1$  к невозмущенному гамильтониану электрона  $\hat{H}_0$ . Здесь  $\hat{\mathbf{v}}$  — оператор скорости электрона,  $u_{ik}$  — тензор деформации кристалла,  $\Lambda_{ik}$  — тензор деформационного потенциала с учетом сохранения числа электронов. Суммирование в (2) производится по всем переменным, задающим состояния электронов, включая спиновые.

Взаимодействие электронов с различными рассеивателями — примесными атомами, дефектами кристаллической решетки, фононами и др. — учитывается оператором столкновений  $\hat{W}_{\text{coll}}$ . Согласно принципу детального равновесия оператор столкновений, действуя на равновесный статистический оператор  $\hat{f}_0$ , обращает его в нуль, т.е.  $\hat{W}_{\text{coll}} \hat{f}_0 = 0$ .

Будем полагать, что возмущение системы электронов звуковой волной с частотой  $\omega$  мало, и в выражении

$$\dot{S} = \text{Sp} \left\{ \hat{W}_{\text{coll}} \hat{f} \ln \frac{1 - \hat{f}}{\hat{f}} \right\} \quad (4)$$

ограничимся асимптотой по малому отклонению статистического оператора от равновесного  $\hat{f}_1 = \hat{f} - \hat{f}_0$ .

В линейном приближении по малому возмущению электронов звуковой волной оператор столкновений  $\hat{W}_{\text{coll}} \hat{f}$  является линейным интегральным оператором, действующим на  $\hat{f}_1$ . Для большей наглядности при вычислении диссипативной функции  $Q$  воспользуемся  $\tau$ -приближением для оператора столкновений, позволяющим представить его в виде оператора умножения  $\hat{f}_1$  на частоту столкновений  $1/\tau$ , а именно:

$$\hat{W}_{\text{coll}} \hat{f}_1 = -\frac{\hat{f}_1}{\tau} \quad (5)$$

В бесстолкновительном пределе, т.е. при  $\omega\tau \gg 1$  явный вид интеграла столкновений не существует, а при  $\omega\tau \ll 1$  представление  $\hat{W}_{\text{coll}} \hat{f}_1$  в виде (5) достаточно обоснованно в ряде случаев, например, при распространении продольного звука в направлении магнитного поля  $\mathbf{H} = (0, 0, H)$ . Этот случай мы рассмотрим ниже и вычислим коэффициент затухания звука  $\Gamma$ , равный отношению диссипативной функции к плотности потока звуковой энергии  $\rho u^2 \omega^2 s/2$ , где  $\rho$  — плотность кристалла,  $s$  — скорость звука,  $u$  — смещение ионов.

При продольной поляризации звука нет необходимости учитывать порожденные акустической волной электромагнитные поля, а без их учета у статистического оператора отличны от нуля только диагональные компоненты. С помощью кинетического уравнения легко получить для матричного элемента  $f_1^{nm}$  следующее выражение:

$$f_1^{nm}(P_y, p_z) \left( ikv_z - i\omega + \frac{1}{\tau} \right) =$$

$$= -\frac{\partial f_0(\epsilon_n)}{\partial \epsilon_n} \Lambda_{ij}^{nm}(P_y, p_z) \dot{u}_{ij}, \quad (6)$$

где  $k$  — волновой вектор. Мы воспользовались калибровкой Ландау для векторного потенциала магнитного поля  $\mathbf{A} = (0, Hx, 0)$ . При этом помимо проекции импульса  $p_z$  хорошим квантовым числом служит также проекция обобщенного импульса  $P_y$ , которая связана с кинематическим импульсом  $p_y$  соотношением  $P_y = p_y + eHx/c$ . В качестве независимых переменных, задающих состояние электрона, выбраны непрерывно меняющиеся  $p_z$  и  $P_y$  и дискретное квантовое число  $n$ , нумерующее уровни энергии электрона в магнитном поле.

Коэффициент поглощения звука нетрудно найти для произвольного вида электронного энергетического спектра. Для определенности рассмотрим слоистый проводник с квазидвумерным электронным энергетическим спектром наиболее простого вида

$$\epsilon(\mathbf{p}) = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} - \eta v_0 \frac{\hbar}{a} \cos \frac{ap_z}{\hbar} \quad (7)$$

в условиях, когда выполнены неравенства

$$T \ll \hbar\Omega \ll \eta\mu \quad (8)$$

Здесь  $a$  — расстояние между слоями,  $v_0$  — фермиевская скорость,  $\Omega = eH/mc$ ,  $m$  и  $e$  — масса и заряд электрона,  $c$  — скорость света,  $\eta \ll 1$  — параметр квазидвумерности.

Компоненту деформационного потенциала можно описать выражением

$$\Lambda_{zz} = \eta m v_0^2 \cos \frac{ap_z}{\hbar} \quad (9)$$

Уровни энергии электрона без учета спинового расщепления

$$\epsilon_n = \hbar\Omega \left( n + \frac{1}{2} \right) - \eta v_0 \frac{\hbar}{a} \cos \frac{ap_z}{\hbar} \quad (10)$$

зависят лишь от двух переменных  $n$  и  $p_z$ , а диссипативная функция системы электронов принимает достаточно простой вид:

$$Q = -\frac{2eH}{c(2\pi\hbar)^2} \sum_n \int_0^{2\pi\hbar/a} dp_z \frac{\partial f_0(\epsilon_n)}{\partial \epsilon_n} \frac{k^2 \omega^2 |\Lambda_{zz} \dot{u}|^2 \tau}{1 + \tau^2 (kv_z - \omega)^2} \quad (11)$$

Подставив

$$\frac{\partial f_0}{\partial \epsilon_n} = - \frac{1}{4T c k^2 [(\epsilon_n - \mu)/2T]}$$

в формулу (10) и воспользовавшись безразмерной переменной  $x = ap_z/\hbar$ , получим следующее выражение для коэффициента затухания:

$$\Gamma = \Gamma_0 \eta^2 \frac{\hbar \Omega}{T} k v_0 \tau \sum_n \int_0^{2\pi} dx F(x) G_n(x), \quad (12)$$

где  $\Gamma_0 = mNv_0\omega/4\pi\rho s^2$ ,  $N$  — плотность носителей заряда,  $\mu$  — химический потенциал,

$$F(x) = \frac{\cos^2 x}{1 + \tau^2 (\eta k v_0 \sin x - \omega)^2},$$

$$G_n(x) = \text{ch}^{-2} \left[ \frac{-\mu + \Omega \hbar (n + \frac{1}{2}) - (\eta \hbar v_0 / a) \cos x}{2T} \right].$$

При  $\omega\tau \ll s/\eta v_0$  функция  $F(x)$  имеет острые максимумы шириной порядка  $1/k\eta v_0\tau$ , однако в большой области звуковых частот, удовлетворяющих условию  $\omega\tau < 1$ , более острыми являются функции  $G_n(x)$ . Ширина максимумов этих функций порядка  $(T/\eta\mu)^{1/2}$ , и с ними связаны наиболее острые пики в поглощении энергии звуковой волны. Они имеют место при значениях магнитного поля, удовлетворяющих условию

$$\mu - \hbar\Omega \left( n + \frac{1}{2} \right) \pm \eta \frac{\hbar v_0}{a} = 0. \quad (13)$$

При этом плотность состояний электронов испытывает особенность, которая и обеспечивает резкое возрастание поглощения электронами энергии звуковой волны. Высота пиков при  $k v_0 \tau \ll \mu/T$  имеет вид

$$\Gamma^{\max} \approx \Gamma_0 \frac{\hbar\Omega}{(T\mu)^{1/2}} \eta^{3/2} k v_0 \tau, \quad (14)$$

а вне максимума фоновая часть функции  $\Gamma(H)$  в  $(T/\eta\mu)^{1/2}$  раз меньше  $\Gamma^{\max}$ . По сравнению со случаем изотропного металла продольный звук, распространяющийся вдоль нормали к слоям квазидвумерного проводника, затухает очень слабо, и график его зависимости от величины магнитного поля  $\Gamma(H)$  лежит значительно ниже, чем аналогичная кривая  $\Gamma_M(H)$  для случая изотропного ме-

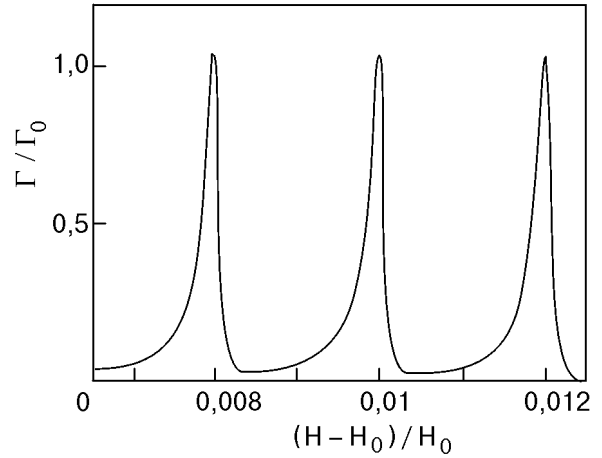


Рис. 1. Зависимость  $\Gamma/\Gamma_0$  от величины  $(H - H_0)/H_0$ , где  $H_0$  удовлетворяет соотношению  $\Omega(H_0)/\mu = 0,02$ ;  $\eta = 0,01$ ,  $\omega\tau = 0,1$ ,  $k v_0 \tau = 5 \cdot 10^2$ ,  $\mu/2T = 10^4$ .

талла. Например, при  $k v_0 \tau < (\mu/T)^{1/2}$  для отношения максимальных значений коэффициента поглощения справедливо выражение

$$\frac{\Gamma^{\max}}{\Gamma_M^{\max}} \approx \eta^{3/2}. \quad (15)$$

На рис. 1 показана зависимость  $\Gamma/\Gamma_0$  от величины сильного магнитного поля.

Нетрудно убедиться, что качественный характер зависимости коэффициента поглощения от величины магнитного поля сохраняется для произвольного квазидвумерного электронного энергетического спектра. В случае произвольного закона дисперсии носителей заряда плотность состояний электронов испытывает особенность, когда площадь сечения поверхности Ферми плоскостью  $p_z = \text{const}$  имеет экстремум как функция  $p_z$ . Таким образом, период осцилляций  $\Gamma(H)$  определяется экстремальной площадью сечения поверхности Ферми.

Приведенные формулы, как было отмечено выше, справедливы в квазиклассическом приближении, когда  $\eta\mu \gg \hbar\Omega$  и химический потенциал слабо зависит от величины магнитного поля. В обратном предельном случае при  $\hbar\Omega > \eta\mu$  в уравнении (13) уже нельзя игнорировать сложную зависимость  $\mu$  от  $H$ . Этот случай заслуживает отдельного рассмотрения, особенно при  $\hbar\Omega \gg \eta\mu$ , когда максимум поглощения энергии звуковых волн расщепляется на дублет, расстояние между вершинами которого пропорционально параметру квазидвумерности проводника.

Рассмотренный выше случай является единственным, когда имеет место аномальная акустическая прозрачность квазидвумерного провод-

ника. При поперечной поляризации звуковой волны, распространяющейся вдоль магнитного поля, направленного по нормали к слоям, возбуждается электромагнитная волна с электрическим полем в плоскости слоев. Это приводит к тому, что джоулевы потери становятся весьма существенными, и в результате коэффициент поглощения звука в слоистом квазидвумерном проводнике совпадает по порядку величины с коэффициентом поглощения в обычном металле с такой же плотностью носителей заряда.

1. А. В. Риппарт, *Philos. Mag.* **2**, 1147 (1958).
2. Э. А. Канер, В. Г. Песчанский, И. А. Привороцкий, *ЖЭТФ* **40**, 214 (1961).
3. В. Л. Гуревич, В. Г. Скобов, Ю. Д. Фирсов, *ЖЭТФ* **40**, 786 (1961).

4. Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, *Статистическая физика*, часть 2, Наука, Москва (1965).
5. Д. Н. Зубарев, *Неравновесная статистическая термодинамика*, Наука, Москва (1971)

#### The oscillatory acoustoelectronic effect in $Q2D$ conductors in a quantizing magnetic field

O. V. Kirichenko and V. G. Peschansky

It is shown that the  $Q2D$  character of the electron energy spectrum of a layered conductor results in an essential attenuation of an the absorption of a longitudinal sound, propagating along a normal to the layers in a quantizing magnetic field.